



(19) 中華民國智慧財產局

(12) 設計說明書公告本

(11) 證書號數：TW D218677 S

(45) 公告日：中華民國 111 (2022) 年 05 月 01 日

(21) 申請案號：110305383

(22) 申請日：中華民國 109 (2020) 年 07 月 08 日

(51) LOC.(13)Cl.：13-99

(30) 優先權：2020/01/17 日本

2020-000750

(71) 申請人：日商東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)
日本(72) 設計人：及川大海 OIKAWA, MASAMI (JP)；高村侑矢 TAKAMURA, YUYA (JP)；坂下訓
康 SAKASHITA, KUNIYASU (JP)

(74) 代理人：何愛文；王仁君

(56) 參考文獻：

TW I648426

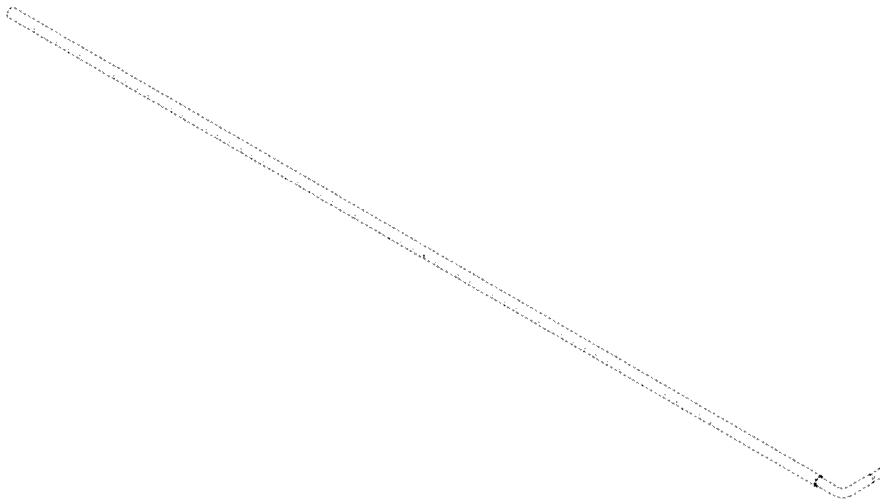
審查人員：蔡俊溢

圖式數：11 共 5 頁

(54) 名稱

半導體成膜裝置用氣體供給噴嘴(三)

代表圖：



【立體圖】



D218677

【設計說明書】

【中文設計名稱】半導體成膜裝置用氣體供給噴嘴(三)

【物品用途】

【0001】 「表示使用狀態之參考剖面圖」中，藍色所表示的本物品係在半導體成膜裝置內設置有1支或複數支，並供給用以在晶圓上進行成膜之氣體者。另外，該圖式中，本物品的形狀係簡化顯示。部分設計所欲主張之部分係用以對晶圓均勻供給氣體之孔。

【設計說明】

【0002】 實線所表示之部分係部分設計所欲主張之部分。虛線所表示之部分係部分設計所不欲主張之部分。

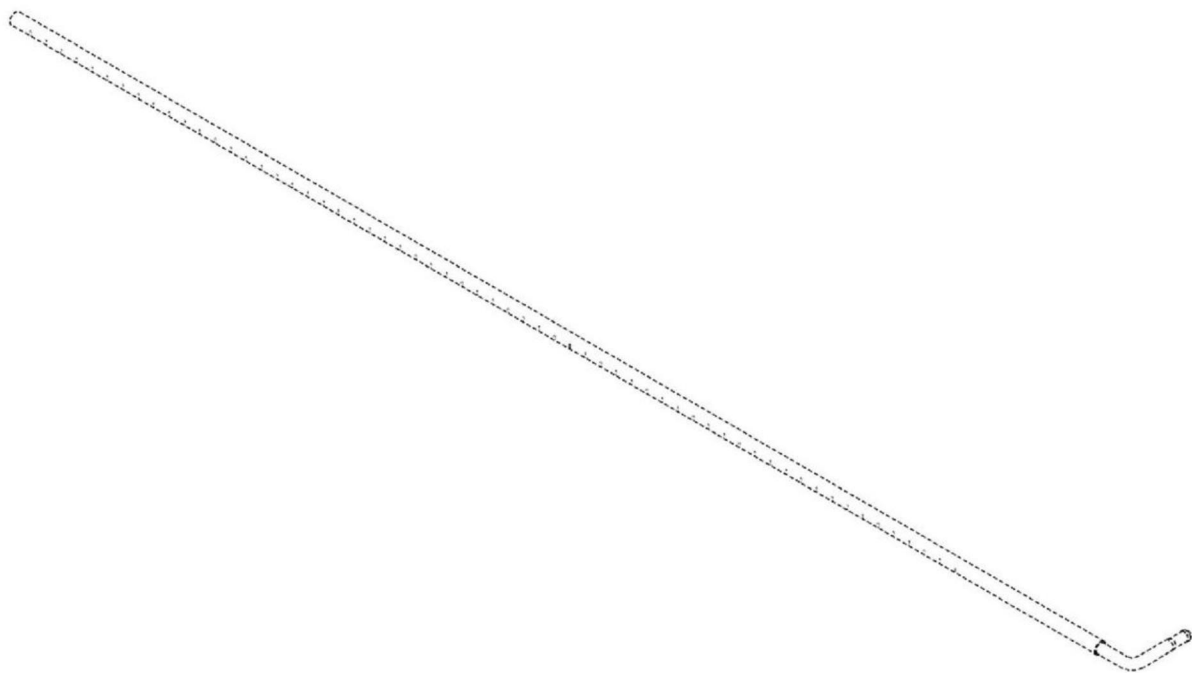
【0003】 包含「立體圖」、「A-A部分放大圖」、「B-B端面圖」、「C-C部分放大圖」及「D-D剖面圖」來特定出部分設計所欲主張之部分。

【0004】 由於仰視圖係顯示為與俯視圖對稱，故省略。

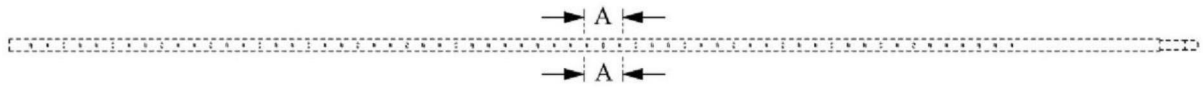
【0005】 「表示使用狀態之參考剖面圖」中之色彩及文字僅為說明及標示而使用者，非為主張之部分。

【設計圖式】

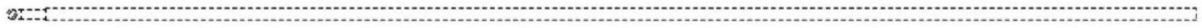
(指定代表圖)



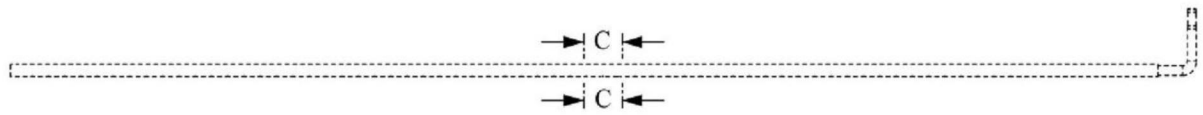
【立體圖】



【前視圖】



【後視圖】



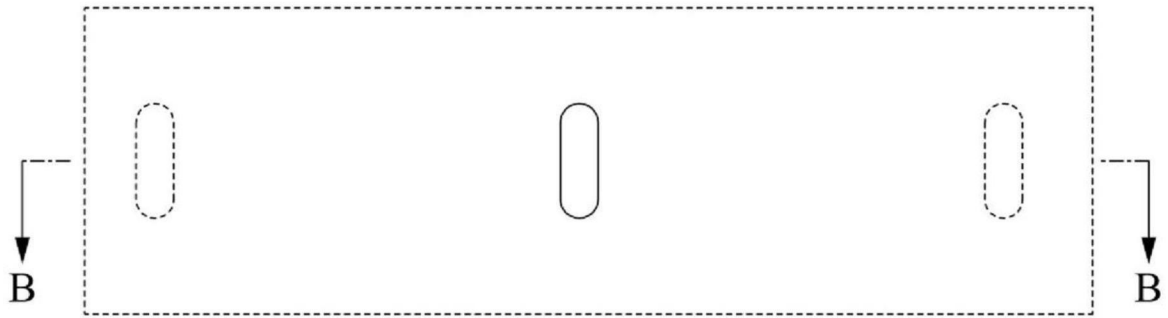
【俯視圖】



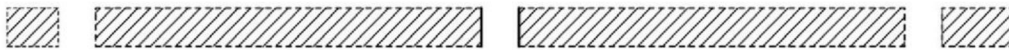
【右側視圖】



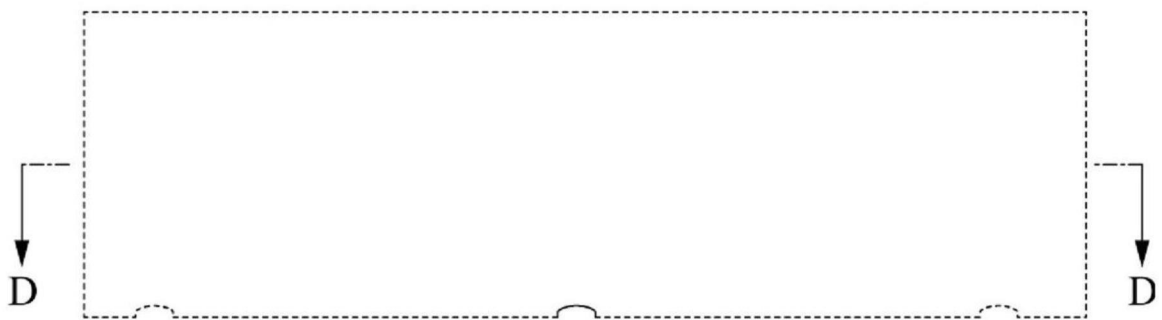
【左側視圖】



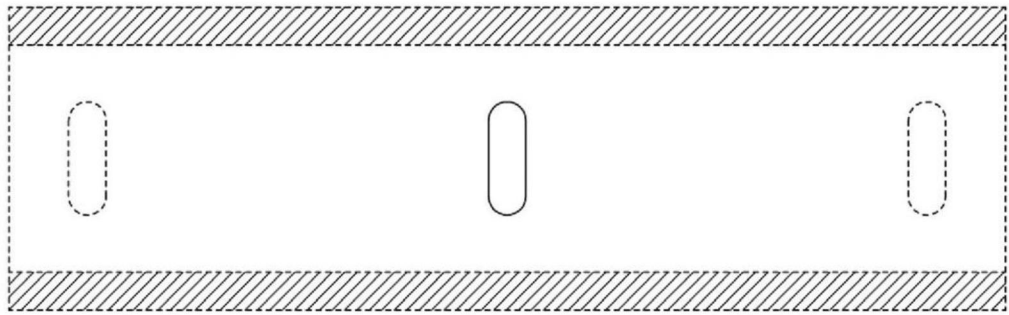
【A-A部分放大圖】



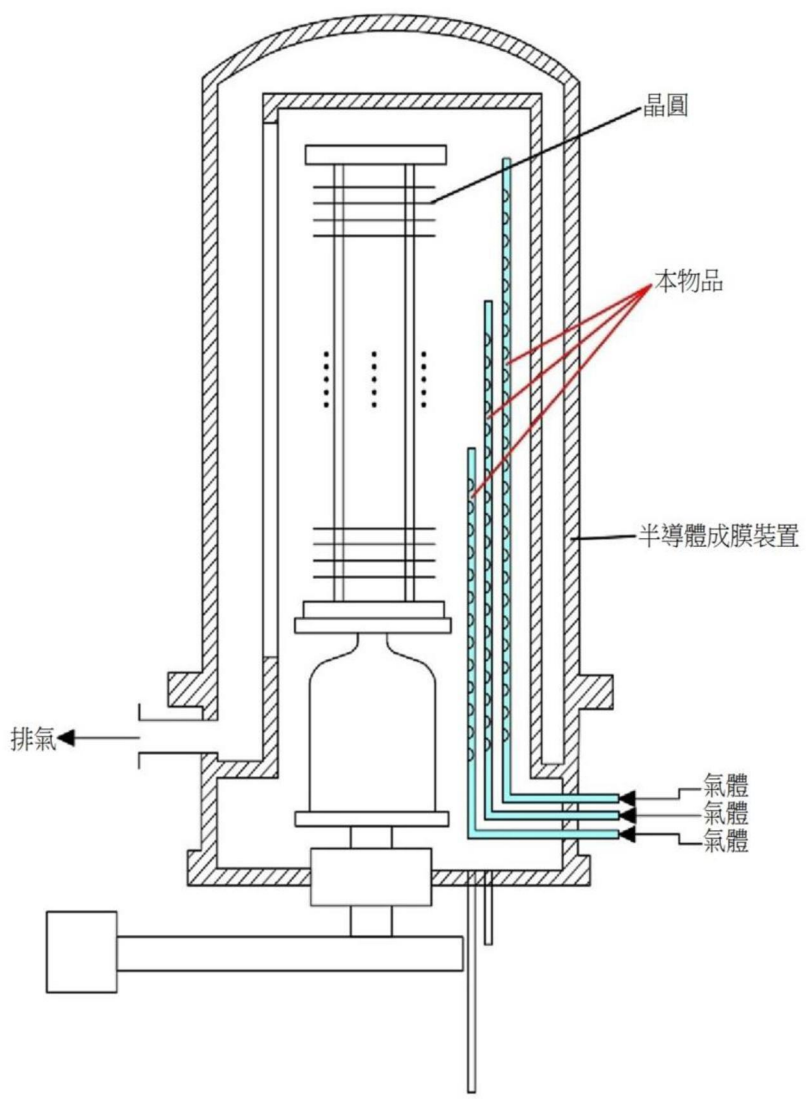
【B-B端面圖】



【C-C部分放大圖】



【D-D剖面圖】



【表示使用狀態之參考剖面圖】